

搭配SiC Trench MOSFET 1200V/180A 全SiC功率模組

BSM180D12P3C007

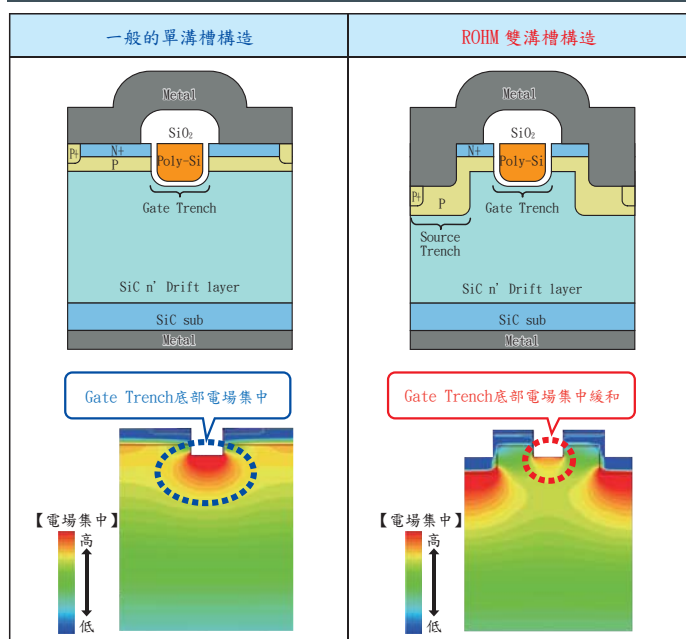


減少導通電阻、提昇開關性能！ 搭配SiC Trench MOSFET 全SiC功率模組登場

產品概要

超越Si的極限、備受矚目的SiC元件。性能不斷進化。ROHM成功量產採用溝槽構造之SiC-MOSFET，相較於量產中的平面型SiC-MOSFET，減少約50%的導通電阻、35%的輸入容量。採用本元件可將1200V180A全SiC功率模組商品化。

■ 採用雙溝槽構造保有長期可靠性！



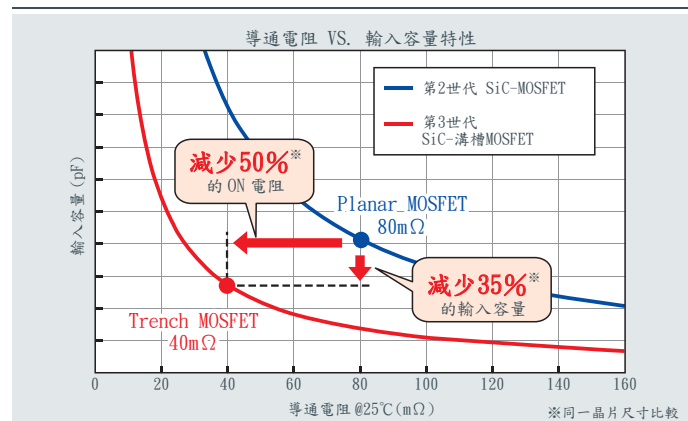
■ SiC溝槽MOSFET模組規格

型號	絕對最大額定 (Ta=25°C)						R _{θ(j-c)} Typ. (mΩ)
	V _{iss} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A) [Tc=60°C]	T _J (°C)	T _{stg} (°C)	Visol(V) [AC 1min.]	
BSM180D12P3C007	1200	-4 ~ +22	180	-40 ~ +175	-40 ~ +125	2500	10

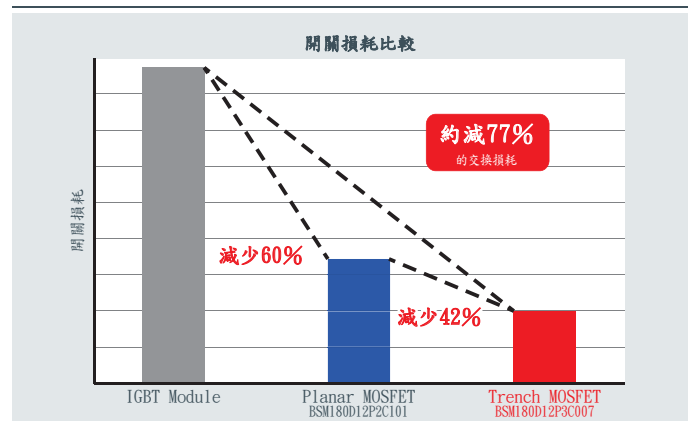
封裝 (C Type)	內部電路圖

(單位: mm)

■ 減少50%的導通電阻特性低減！



■ 大幅減低開關損耗！



■ Trench MOSFET個別半導體產品也將擴增

將650V, 1200V額定的產品以3個料號依序展開。產品額定電流包含118A (650V), 95A(1200V)。

本文件中所述之產品規格僅供參考。如需實際使用，請另行索取產品規格書。本文資料所引用的數據，皆為謹慎製作，以期達到正確無誤。若萬一因該數據的錯誤/誤植而引起客戶方面的損害，ROHM恕不負責。關於本資料所記載的技術資料，為產品的典型工作方式及應用電路範例，並不表示將原本屬於ROHM或其他公司的智慧財產權藉由銷售該產品明示地或默示地承諾將使用權利轉移給購買者。因使用上述技術資料所發生的紛爭，ROHM恕不負責。本產品為特定機器、裝置所設計的產品，請務必確定該機器及裝置是否受到海關限制出口使用。 本文件內容以2016年01月21日為準。